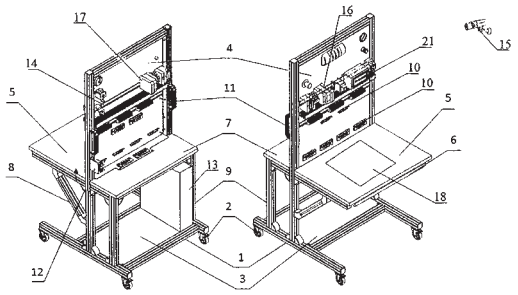
płyty czołowej zamontowane są elementy wyposażenia dydaktycznego przyłączonego do skomunikowanego z siecią Internet serwera (13) z jakim współpracuje co najmniej jedna kamera CCD (15).

(10 zastrzeżeń)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) **408216** (22) 2014 05 16

(51) *H01M 4/36* (2006.01)
H01M 4/04 (2006.01)
C01D 1/02 (2006.01)
C01G 49/02 (2006.01)
B22F 3/10 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) MOLENDA JANINA; ŚWIERCZEK KONRAD; ZAJĄC WOJCIECH; KULKA ANDRZEJ

(54) **Sposób otrzymywania katody, zawierającej aktywny elektrochemicznie tlenek litowo-żelazowy**

(57) Sposób otrzymywania katody, zawierającej aktywny elektrochemicznie tlenek litowo-żelazowy o strukturze α-$LiFeO_2$ i wzorze ogólnym $LiFe_{a-b}M_bO_2$, gdzie M oznacza co najmniej jeden metal wybrany z grupy obejmującej: Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Sn i Mo, 0 < a, b< 1. Sposób charakteryzuje się tym, że zhomogenizowane stałe reagenty, zawierające jony Li^+, Fe^{2+} i/lub Fe^{3+} i MoO_4^{3-} oraz ewentualnie M^{2+} i/lub M^{3+} poddaje się obróbce termicznej polegającej na ich nagrzewaniu do temperatury 400 - 900°C i wygrzewaniu przez okres minimum 10 godzin, po czym z uzyskanego sproszkowanego materiału wykonuje się katodę, a następnie zestawia się ogniwo litowe, które poddaje się cyklom ładowania/rozładowania w zakresie napięć 4,8 - 1,2 V.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **408273** (22) 2014 05 20

(51) *H01S 5/00* (2006.01)
H01S 5/323 (2006.01)
H01S 5/34 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa

(72) GUTOWSKI PIOTR; BUGAJSKI MACIEJ; PIERŚCIŃSKI KAMIL; KARBOWNIK PIOTR

(54) **Heterostruktura kwantowego lasera kaskadowego**

(57) Przedmiotem wynalazku jest heterostruktura kwantowego lasera kaskadowego (QCL) o układzie materiałowym AlGaAs/InGaAs/GaAs, przeznaczona dla zastosowań, w których nie jest konieczna praca ciągła lasera, jak na przykład układy do detekcji śladowych ilości substancji gazowych. Heterostruktura ta posiada podłoże z GaAs, warstwy falowodu, pomiędzy którymi znajduje się obszar aktywny supersieci zawierający warstwy studni kwantowych InGaAs oraz warstwy barier AlGaAs. W heterostrukturze tej każda z warstw studni kwantowych $In_xGa_{1-x}As$ zawiera Ind w ilości 0 < x < 0.05, a warstwy barier $Al_yGa_{1-y}As$ zawierają Glin w ilości 0.40 < y < 1.00.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **408156** (22) 2014 05 09

(51) *H02B 1/00* (2006.01)
H02B 1/01 (2006.01)
H02B 1/26 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)

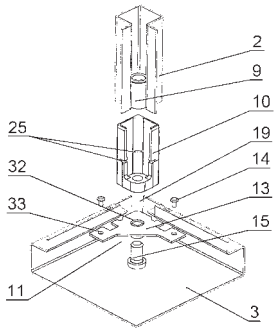
(71) ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, Przygórze

(72) RADWAŃSKI ANDRZEJ

(54) **Szkielet szafy telekomunikacyjnej**

(57) Szkielet szafy telekomunikacyjnej zawierający cztery pionowe słupy, płytę dolną i płytę górną, przy czym po obu stronach każdego pionowego słupa posiada przyspawane tuleje z gwintem oraz w każdym wierzchołku płyty dolnej jak i płyty górnej narożnik i wkładkę, charakteryzuje się tym, że w wierzchołku (11) płyty dolnej (3), jak i płyty górnej, znajduje się narożnik (10), jako element odlewany o kształcie podobnym do prostopadłościanu o podstawie kwadratu, przytwierdzony na stałe za pomocą stożkowych nitów do danej płyty (3) i wkładka usztywniająca (13), o kształcie płaskiego równomiernego trójkąta prostokątnego, też przytwierdzona na stałe do górnych elementów danej płyty (3) za pomocą specjalnych nitów (14), przy czym ścięty wierzchołek wkładki usztywniającej (13) znajduje się w rozcięciu (25), o szerokości odpowiadającej w przybliżeniu grubości wkładki usztywniającej (13), wykonanym w naddatku narożnika (10), zaś równoległe krawędzie zewnętrznych pierwszych wycięć wkładki usztywniającej praktycznie stykają się z dnem rozcięcia (25) w ścianach narożnika (10), a prostopadłe krawędzie zewnętrznych pierwszych wycięć wkładki usztywniającej (13) opierają się o ściany tego narożnika (10), natomiast przewleczona przez środkowy otwór (32) we wkładce usztywniającej (13), śruba (15), współpracująca z tuleją z gwintem (9), osadzona jest ruchomo w gnieździe utworzonym między górną powierzchnią naby narożnika (10) i dolną powierzchnią wkładki usztywniającej (13).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **409504** (22) 2014 09 15

(51) *H02B 13/00* (2006.01)
H01B 17/26 (2006.01)
H01H 73/06 (2006.01)

(71) VOLTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica

(72) CĄBER BŁAŻEJ; RODZIEWICZ-CĄBER TOMASZ; SZERMER ZBIGNIEW